

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2008 г.

№ 186

г. Киев

Об итогах работы собрания Секции
по проблемам функциональных
материалов электронной техники Научного
совета по новым материалам при МААН

15-17 октября 2008 года в Москве на базе РАН состоялось первое собрание Секции по проблемам функциональных материалов электронной техники Научного совета по новым материалам при МААН (далее – Секция).

В собрании приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, России и Украины. На собрании были заслушаны 10 научных докладов, а также сообщения представителей национальных академий наук о состоянии работ по материалам для электронной техники и возможных формах совместных работ фундаментального и прикладного характера. Члены Секции посетили ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон» (Зеленоград) – ведущее предприятие в электронной промышленности России. В ходе посещения состоялся обмен информацией и обсуждение возможного участия в развитии производства. Руководство ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон» выразило готовность на долгосрочное сотрудничество с материаловедцами стран СНГ.

По итогам работы собрания Секции был принят ряд решений, утвержден план мероприятий на 2009 г., который прилагается и определено, что следующее ее собрание будет проведено в 2009 году в Харькове.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Одобрить работу Секции по проблемам функциональных материалов электронной техники Научного совета по новым материалам при МААН и принять к сведению ее решение.

2. Просить Национальную академию наук Украины оказать помощь в проведении в 2009 году в Харькове собрания Секции по проблемам функциональных материалов электронной техники Научного совета по новым материалам при МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины



Б.Е.Патон

План мероприятий
Секции по проблемам функциональных материалов
электронной техники Научного совета
по новым материалам при МААН на 2009 гг.

1. Заседание представителей Секции от НАН Украины в ходе работы Научного совета по проблеме „Физика полупроводников и полупроводниковые устройства” (февраль 2009 г., г. Киев).

2. Участие членов Секции в определении разработок, рекомендованных к внедрению в производство, в ходе работы 10-й Международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии” (18-22 мая 2009 г., г. Одесса, Украина).

3. Заседание представителей Секции в ходе проведения XII Международной конференции по физике и технологии тонких пленок и наносистем (май 2009 г., г. Ивано-Франковск, Украина).

4. Обсуждение планов сотрудничества по кремниевой тематике участниками Секции во время работы IV Украинской конференции по физике полупроводников с международным участием (сентябрь 2009 г., г. Запорожье, Украина).

5. Годичное общее собрание Секции с подведением итогов за 2009 г. и принятием планов на 2010 г. (октябрь-ноябрь 2009 г., г. Харьков, Институт монокристаллов НАН Украины).